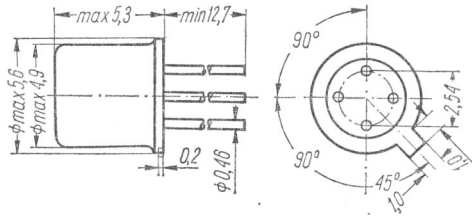


3SK20H



Typ tranzystora: tranzystor krzemowy

Firma: HITACHI

Wykonanie: tranzystor polowy MOS (kanał typu N), w obudowie metalowej TO-72

Zastosowanie: wzmacniacze wejściowe o dużej impedancji wejściowej

Rys. 1-1272. 2SK20H

Wartości charakterystyczne¹⁾

	min	typ	max		
$U_{(BR)DSX}$	20			V	przy $I_D = 10 \mu A$, $U_{G1S} = -6 V$
I_{G1SS}			1,0	pA	przy $U_{G1S} = -6 V$, $U_{DS} = 0$
U_{G1SC}			-3,5	V	przy $I_D = 10 \mu A$, $U_{DS} = 6 V$
I_{DSS}	0,4	3,0	5,0	mA	przy $U_{DS} = 6 V$, $U_{G1S} = 0$
γ_{21s}	0,6			mS	przy $U_{DS} = 6 V$, $I_D = I_{DSS}$, $f = 1 kHz$
γ_{22s}			180	μS	przy $U_{DS} = 6 V$, $I_D = I_{DSS}$, $f = 1 kHz$
C_{11s}		5,0		pF	przy $U_{DS} = 6 V$, $I_D = I_{DSS}$, $f = 1 MHz$
U_n		0,2		$\mu V/Hz$	przy $U_{DS} = 6 V$, $I_D = 1 mA$, $f = 1 kHz$, $R_g = 1 M\Omega$

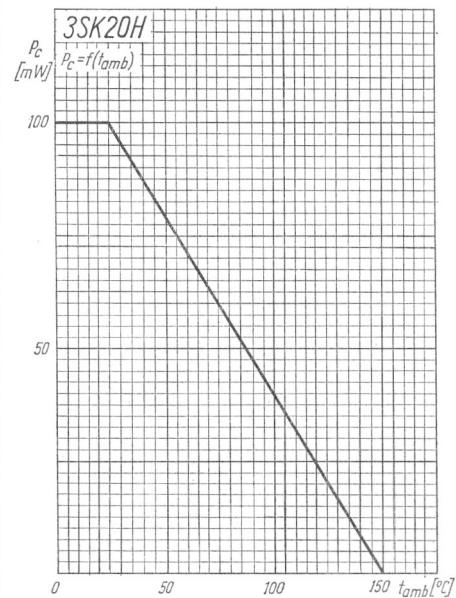
Wartości graniczne

$U_{DSX} max$	20 ²⁾	V	$P_{tot} max$	100	mW
$U_{G1SX} max$	+5 ³⁾	V	$t_j max$	150	$^{\circ}C$
$U_{G1SO} max$	± 20	V	t_{stg}	-55 ÷ +150	$^{\circ}C$
$I_D max$	10	mA			

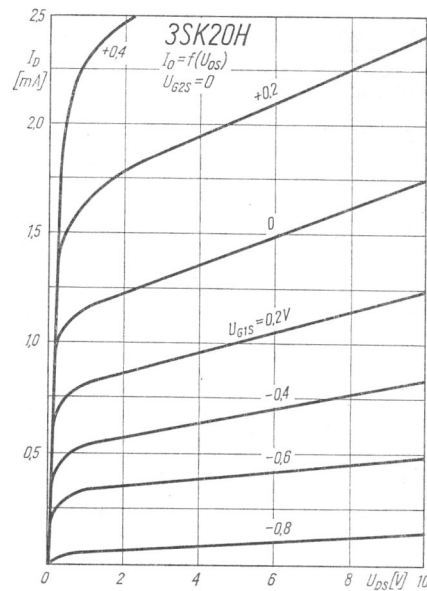
¹⁾ $t_{amb} = 25^{\circ}C$

²⁾ $U_{G1S} = -6 V$

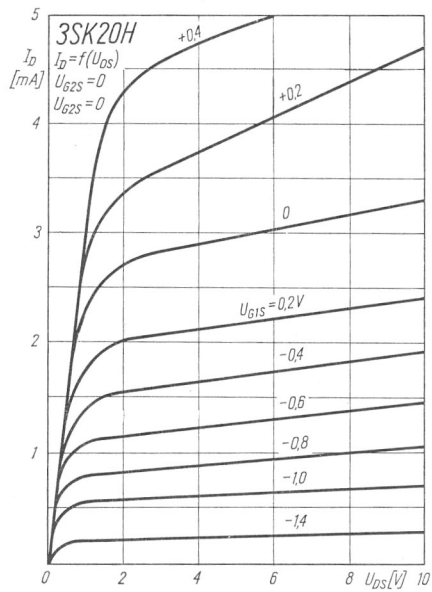
³⁾ $U_{DS} = 1 V$



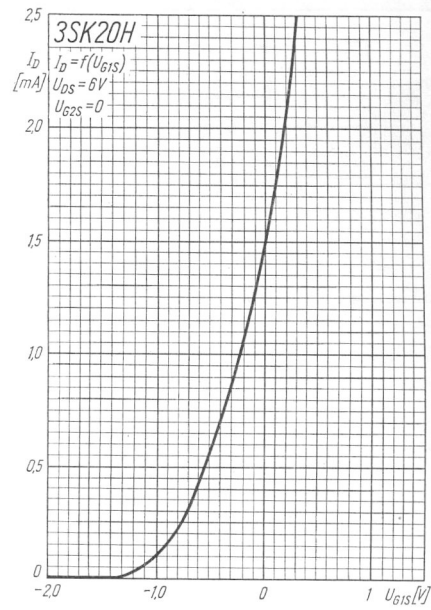
Rys. 1-1273. Zależność dopuszczalnej mocy strat od temperatury otoczenia



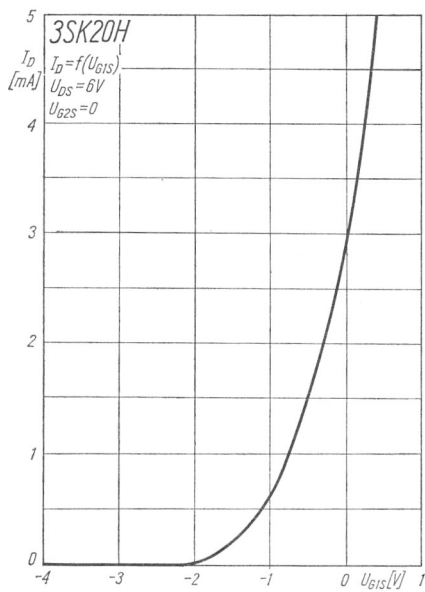
Rys. 1-1274. Charakterystyki statyczne tranzystora



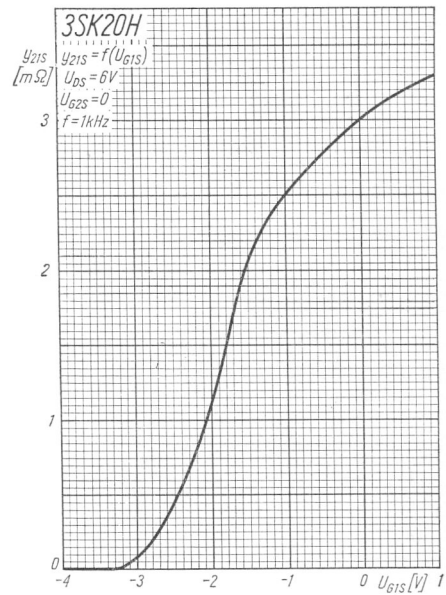
Rys. 1-1275. Charakterystyki statyczne tranzystora



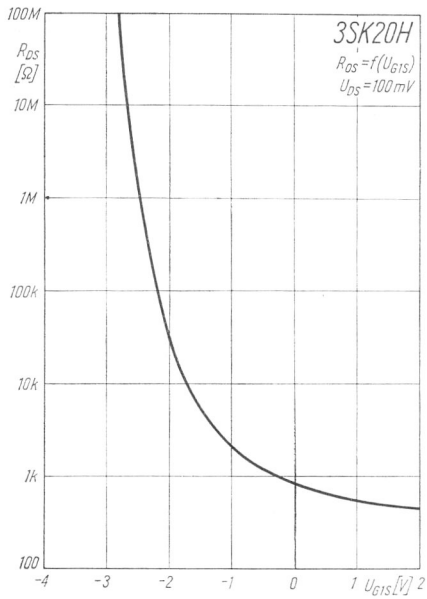
Rys. 1-1276. Zależność prądu drenu od napięcia bramki U_{G1S}



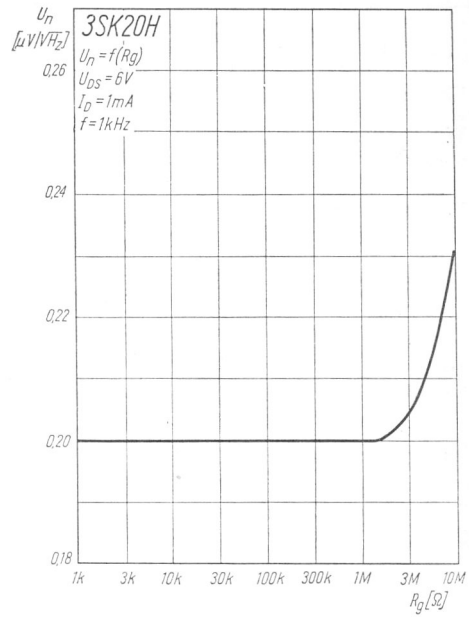
Rys. 1-1277. Zależność prądu drenu od napięcia bramki U_{G1S}



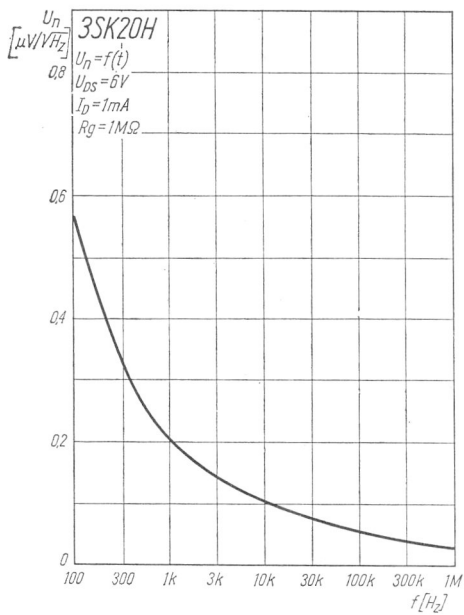
Rys. 1-1278. Zależność admitancji y_{21s} od napięcia bramki U_{G1S}



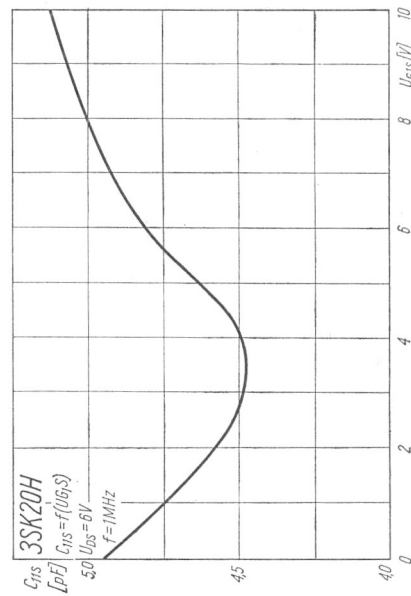
Rys. 1-1279. Zależność rezystancji R_{DS} od napięcia bramki U_{G1S}



Rys. 1-1280. Zależność napięcia szumów od rezystancji wejściowej



Rys. 1-1281. Zależność napięcia szumów od częstotliwości



Rys. 1-1282. Zależność pojemności wejściowej od napięcia bramki U_{G1S}